

## РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу MOSFET on TMD, представлену на Конкурс

(шифр)

3

Електроніки

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№ з/п	Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи <sup>1</sup>	Рейтингова оцінка. Максимальна кількість балів (за 100-бальною шкалою)	Бали
1	Актуальність проблеми	10	10
2	Новизна та оригінальність ідей	15	
3	Використані методи дослідження	15	
4	Теоретичні наукові результати	10	
5	Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи)	20	
6	Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації	5	
7	Ступінь самостійності роботи	10	
8	Якість оформлення	5	
9	Наукові публікації	10	
10	Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9):		
10.1	Тема дослідження безсумнівно є актуальною.		
10.2	<p>Робота у тому вигляді, у якому вона подана на конкурс має ознаки самоплагиату, оскільки судячи з додатку, автором роботи є К.О. Корж, а робота містить виклад результатів уже опублікованої статті М.В. Стріха, К.О. Корж, Фундаментальні межі довжин каналів провідності польових транзисторів на моношарах дихалькогенідів перехідних металів, Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, 19 (2022) 4-18 (<a href="http://semst.onu.edu.ua/article/view/258446/257455">http://semst.onu.edu.ua/article/view/258446/257455</a>), зокрема практично дослівно повторює висновки статті, містить рисунки (рис. 8-9) з опублікованими результатами. При цьому, автор конкурсної роботи не посилається на цю статтю у списку використаних джерел, подає зміст і висновки опублікованої статті як нові, не вказує на свій особистий внесок в отримання результатів і взагалі не розрізняє одноосібну конкурсну роботу від опублікованої у співавторстві статті. Основний предмет, який досліджується у рецензованій роботі і відображений у її назві, є змістом низки статей проф. М.В. Стріхи з подібними назвами, опублікованих зі співавторами. Назва конкурсної роботи звучить навіть більш загально по відношенню до опублікованих робіт з цієї тематики. У вступі навіть задекларована мета конкурсної роботи як послідовний теоретичний опис MOSFET систем. Він справді наявний в оглядовій частині, де зокрема Рис. 5 і 6 у конкурсній роботі запозичені з вищезгаданої статті, однак без посилання на першоджерело. В основній частині конкурсної роботи наведені результати розрахунків за формулою, яка наведена за оглядом літератури. Це лише підкреслює суперечність, викладену вище.</p> <p>Отже, у підсумку можна констатувати, що подана на конкурс робота містить результати досліджень, які отримані і опубліковані у співавторстві, без належного цитування і опису творчого внеску автора конкурсної роботи у представлені результати. За усіма критеріями 1-4 конкурсна робота може бути оцінена високо,</p>		

	однак з огляду на вищевказане, ставить автора в неоднакові умови з іншими конкурсантами, що порушує основні принципи конкурсу студентських наукових робіт. З цієї причини, вважаю, що її не слід оцінювати подібно до самостійних робіт студентів.
Сума балів	10